

Bibliographie

Bibliographie

- [1] : P.mounaix, heterostructures doubles barriere pour la realisation de diodes et de transistors à effet tunnel résonnant, these de doctorat, université des sciences et technologies de lille, 1992.
- [2] : S .dehimi, etude de LASERS à base des composés semiconducteurs(InP, GaAs, GaP), mémoire de magister, universite de batna,2011.
- [3] : R.aouati, etude de l'interaction électron- matière des nanostructures de l'arséniure de gallium, these de doctorat en science, universite de constantine,2011.
- [4] : R.castagné et all,circuits integrés en arséniure de gallium, physique, technologie et régles de concetion, Masson et Cinet ENST Paris,1989. .
- [5] : H.mathieu, physique des semicpnducteurs et des composants électroniques, Masson,1987.
- [6] : G.bastard, wave machanics applied to semiconductor heterostrctures, les editions de physique, paris,1988
- [7] : C.kittel, introduction à la physique de l'etat solide, Dunod, 1972 .
- [8] : S.laval, physique des semiconducteurs III-V, institut d'electronique fondamentale, CNRS(ura022), université paris sud.
- [9] : C.teyssendier, contribution à la modelisation non lineaire de transistors de puissance HEMT pseudomorphique sur substrat AsGa : Analyse des effets parasites, these de doctorat, université de limoges,2008.
- [10] : C.A mead, Schottky barrier gate field effect transistors, Proc IEEE, Vol 54, 1966.
- [11] W W.hooper and W.l.leher, An epitaxial GaAs field effect transistors, Proc IEEE, Vol 55, 1967.
- [12] : S.khemissi, modelisation non lineaire des composants à effet de champ, these de doctorat, universite de constantine,2009.
- [13] : E.byk, Méthodes d'analyses couple des pour la modelisaton globale de composants et modules millimetriques de forte puissance, these de doctorat, université de limoges,2002.
- [14] : S. mouetsi, contribution à l'etude du bruit basse frequence dans des heterostructures AlGaAs/GaAs/AlGaAs, these de doctorat, universite de reims, 2010.
- [15] : J.M.bonard, etude par microscopie electronique des proprietes structurales et optiques de laser à semiconducteur,these de doctorat, ecole polytechnique de losanne,1996.

Bibliographie

- [16] : L.becerra, hétérostructures et dispositifs microelectroniques à base d'oxydes high-k sur silicium par EJM, these de doctorat, ecole centrale de Lyon,2008.
- [17]: M.kostrzewa, these de doctorat, ecole centrale de Lyon,2003
- [18] : D.K.ferry, S.M.goodnik, transport in nanostructures, Cambridge université presse,1997.
- [19] : R.dingel et all,appl, phys,lett, 33,665,1978 .
- [20]: L.burgnies, mecanismes de conduction en regime balistique dans les dispositifs electroniques quantiques, these de doctorat., universite de Lille, 1997.
- [21] : A.cappy,proprietes physique et performances potentielles des composants à effets de champ : structure conventionnelles et a gaz d'électrons bidimensionnel,these d e doctorat,univ de lille,1986.
- [22] F.stern, self-consistent results for n-type Si inversion layers,phys.rev B5(12),1972,PP4891-4899 .
- [23] D.delagebeaudeuf, and N.T.linh, Metal-nAlGaAa-GaAs two dimensionel electron gas FET, IEEE transactions on electron devices ED-29(6), 1982,pp955-96.
- [24] C.versnaeyen, etude theorique et experimentale du transistor à effet de champ à heterojonction AlGaAs/GaAs, these de doctorat, universite des sciences et technologies de lille,1985.
- [25] M. moreau, modelisation et simulation numerique des nano-transistors multi-grille à materiaux innovants, these de doctorat, universite de provence (aix marseille I),2010.
- [26] J.dickersons, heterostructure polarization charge engineering for improved and novel III-V semiconductor devices, scool of electrical and computer engenieering, Georgia institute of technology, 2014